

Deutsche Kristallzüchtungstagung 2015 (vorläufiges Programm)

Mittwoch, 04. März 2015	Donnerstag, 05. März 2015	Freitag, 06. März 2015
Registrierung & Get together 12.00 – 13.00 Uhr	D: Epitaxie 08.30 – 10.20 Uhr	G: Silicium 09.00 – 10.20 Uhr
Grußworte 13.00 – 13.30	S. Fritze M. Heuken K. Kachel C. Schröter C. Dubs	D. Schwabe T. Lehmann S. Riepe S. Kayser
A: Angewandte Simulation 13.30 – 14.40 Uhr K. Kakimoto D. V. Berkov P. Bönisch	Kaffeepause 10.20 – 10.50 Uhr	Kaffeepause 10.20 – 10.50 Uhr
Kaffeepause 14.40 – 15.10 Uhr	E: Intermetallische & Oxide 10.50 – 13.00 Uhr	H: Kinetik & Methoden 10.50 – 12.20 Uhr
B: Massive Halbleiter 15.10 – 17.00 Uhr Z. Galazka D. J. Kok C. Hartmann F. Langhans S. Kollowa	A. Bauer P. Sass P. Pupal P. Gille K. Kliemt N. Caroca-Canales	C. E. Krill S. Schimmel S. Besendörfer D. Kaminzky
Kaffeepause 17.00 – 17.30 Uhr	Mittagspause 13.00 – 14.00 Uhr	Schlussworte 12.20 – 12.30
C: Preisträgervorträge 17.30 – 19.00 Uhr A. Jesche, <i>DGKK-Nachwuchspreis</i> A. Erb, <i>Preis der DGKK</i>	Postersession (dazu Kaffee) 14.00 – 16.00 Uhr	Mittagspause 12.30 – 13.30 Uhr
<i>DGKK-Mitgliederversammlung</i> ab 19.30 Uhr	F: Plenarsession 16.00 – 17.45 Uhr A. Cröll A. Revcolevschi W. Aßmus	Führungen Kristall- und Materiallabor (optional) ca. 13.30 – 14.30 Uhr
	<i>Führung Campus Westend</i> 19.00 – 19.30 Uhr	
	<i>DKT – Konferenzdinner</i> Casino, Campus Westend ab 19.30 Uhr	

Session A
Angewandte Simulation

Mittwoch 04. März 2015 13.30 – 14.40

Sessionleiter: Lev Kadinski

13.30 – 14.00

Koichi Kakimoto

Crystal growth of atomic scale and macro scale calculations

14.00 – 14.20

Dmitry Berkov

Numerical method for calculating the stress field induced by an
arbitrary spatial distribution of dislocations

14.20 – 14.40

Paul Bönisch

Modellierung der Schmelzströmung für die industrielle Photovoltaik

Session B

Massive Halbleiter

Mittwoch 04. März 2015 15.10 – 17.00

Sessionleiter: Peter Wellmann

15.10 – 15.40

Zbigniew Galazka

Bulk crystal growth and properties of transparent semiconducting sesquioxides: β -Ga₂O₃ and In₂O₃

15.40 – 16.00

Dirk J. Kok

Temperature dependent optical absorption of strontium titanate

16.00 – 16.20

Carsten Hartmann

Züchtung und Charakterisierung von hochperfekten AlN-Volumenkristallen mit optimierten optischen und elektrischen Eigenschaften

16.20 – 16.40

Frank Langhans

Dislocation processes in AlN bulk crystals analyzed by laser scattering tomography

16.40 – 17.00

Sandro Kollowa

Züchtung und Charakterisierung von Si-dotierten AlN-Volumenkristallen

Session C
Preisträgervorträge

Mittwoch 04. März 2015 17.30 – 19.00

Sessionleiter: Jochen Friedrich

17.30 – 18.10

Anton Jesche

Solution growth of nitrides and pnictides

18.10 – 18.50

Andreas Erb

Single crystal growth of various oxide materials for basic research
and applications

18.50 – 19.00

Preisverleihung

Session D

Epitaxie

Donnerstag 05. März 2015

08.30 – 10.20

Sessionleiter: Michael Heuken + Stephanie Fritze

08.30 – 09.00

Stephanie Fritze

In-Situ Monitoring to understand and optimize epitaxial growth

09.00 – 09.20

Michael Heuken

CLOSE COUPLED SHOWERHEAD® MOCVD TOOL FOR ADVANCED
GAN BASED BLUE LED MANUFACTURING

09.20 – 09.40

Krysztof Kachel

Growth of Carbon Doped GaN Layers by PHVPE

09.40 – 10.00

Christopher Schröter

In-situ curvature and thickness monitoring of GaN during hydride
vapour phase epitaxy

10.00 – 10.20

Carsten Dubs

Charakterisierung von Submikrometer Yttrium-Eisengranat-
Schichten hergestellt mittels Flüssigphasenepitaxie

Session E
Intermetallische & Oxide

Donnerstag 05. März 2015

10.50 – 13.00

Sessionleiter: Andreas Erb

10.50 – 11.20

Andreas Bauer

Optical float zoning of intermetallic compounds

11.20 – 11.40

Paul Sass

Optical floating zone crystal growth under high-pressure atmospheres – advantages and applications

11.40 – 12.00

Pascal Puphal

Stabilisation of the tetragonal structure in $(\text{Ba,Sr})\text{Cu}(\text{Si,Ge})_2\text{O}_6$

12.00 – 12.20

Peter Gille

Forced convection in high-temperature solution growth by the Bridgman method

12.20 – 12.40

Kristin Kliemt

Kristallzüchtung von YbNi_4P_2 mittels der Bridgman- und der Czochralski-Methode

12.40 – 13.00

Nubia Caroca-Canales

Crystal growth of EuNi_2P_2 and CeRh_2Si_2

Session F

Plenarsession

Donnerstag 05. März 2015

16.00 – 17.45

Sessionleiter: Cornelius Krellner

16.00 – 16.35

Arne Cröll

tba

16.35 – 17.10

Alexandre Revcolevschi

Crystal growth, characterization and physical properties of correlated electron oxide crystals

17.10 – 17.45

Wolf Aßmus

Skull Melting of Cubic Zirconia

Session G Silicium

Freitag 06. März 2015

09.00 – 10.20

Sessionleiter: Peter Rudolph

09.00 – 09.20

Dietrich Schwabe

Über die Begrenzung der Czochralski-Kristallzüchtungsmethode
durch den Übergang von Zylinder- zu Spiral-Wachstum

09.20 – 09.40

Toni Lehmann

Understanding the performance of fine grained vs. conventional mc-
Si, based on grain size, -orientation and -boundary type distribution

09.40 – 10.00

Stephan Riepe

Einfluss der Ankeimphase auf die Materialqualität von High
Performance Multicrystalline Silicon für Solarzellen

10.00 – 10.20

Stefan Kayser

Noval Study of Lateral Photovoltage Scanning- (LPS) and Scanning
Photoluminescence (SPL) Method

Session H

Kinetik & Methoden

Freitag 06. März 2015

10.50 – 12.20

Sessionleiter: Wolfram Miller

10.50 – 11.20

Carl E. Krill

Hipsters vs. Robber Barons: The Psychology of Coarsening in a Polycrystalline World

11.20 – 11.40

Saskia Schimmel

In Situ X-Ray Imaging of GaN under ammonoothermal Conditions – Application for GaN Solubility Measurements

11.40 – 12.00

Sven Besendörfer

Einsatz von C-AFM zur Bestimmung der elektrischen Auswirkungen von Versetzungen in GaN-Leistungsbau-elementen

12.00 – 12.20

Daniel Kaminzky

Abbildende Defektlumineszenzmessungen an 4H-SiC mittels UV-PL